## 古典分子動力学法による固体の熱伝導

Calculation of Heat Conduction of Solid by Classical Molecular Dynamics Method

\*崔 淳豪(東大院学) 伝正 丸山 茂夫(東大院)

Soon Ho CHOI and Shigeo MARUYAMA

Dept. of Mech. Eng., The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656

The thermal conductivity of a solid with a finite size was investigated with the classical molecular dynamics method. Solid argon is selected as the target material since it is well known to be expressed with the simple Lennard-Jones potential and no electron effect is expected on the thermal conductivity. The calculated values by MD simulation are compared with the available bulk experimental data. We confirm that there are the size and pressure effect on the thermal conductivity than that of the bulk material in the heat transfer direction. Also the temperature dependence is carefully investigated and a good agreement with the experimental trend is obtained for the relatively high temperature region. On the other hand, the ability of a classical MD is limited in the low temperature region where quantum nature of vibration is apparent through the specific heat.

Keywords: Molecular Dynamics Heat Conduction, L-J Potential, Size Effect, Thermal Conductivity

## 1. はじめに

近年,薄膜積層技術の発展に伴い厚さ数 Åから数百µm までの薄膜製作が可能となり,主に集積回路の基板として 使用される.このような薄膜デバイスの運用は発熱制御や 放熱性能によって左右されるため薄膜の熱伝導伝熱解析 は極めて重要である<sup>(1)</sup>.最近のMEMS分野の熱伝導実験の 結果からフーリエ則の適用に限界があることやエピタキ シャルな接合面でも大きな熱抵抗が存在することが議論 され,薄膜を積層したsuper-latticeによる優れた断熱物質の 開発も試みられている<sup>(2,3)</sup>.本研究では薄膜のサイズ効果に よる熱伝導劣化のメカニズムを探る第一歩として有限の アルゴン固体の熱伝導に関する分子動力学解析を行った.

## 2. 計算方法

アルゴン分子は Table 1 のパラメータを用いた Lennard-Jones(12-6)ポテンシャルで表現した. 運動方程式の 積分には誤差が $\Delta t^3$ に比例する速度 Verlet 法を用いた.

Fig.1 のようなアルゴン分子の fcc <111>面を並べた固体 系を用いて熱伝導解析を行った.固体系は最下の3層と最 上3層を固定分子層とし,隣接する3層に対する速度スケ ーリングによって温度差を与える.系の温度分布はこれらの分子層を除いた層で計算した.周知のとおりに固体系は 圧縮率が非常に小さいため分子密度のわずかな変化によっても系内部の圧力(応力)が激しく変化する.よって熱伝 導率の計算の前に様々な温度に対して固体内部の圧力が ほとんどゼロになる分子間距離を計算した.Fig.2の(a)は系 の温度を10K,40K,60Kにした時の分子間距離による系の内 部圧力の変化を示したもので,(b)は内部圧力が0になった 場合の分子間距離に対して従来の計算結果<sup>(4)</sup>と実験値<sup>(5)</sup>と 比較したものである.L-Jポテンシャルのカットオフなど によってわずかに変化するがおおよそ実験と良い一致を

Table 1 L-J Potential Parameter

Length Parameter, $\sigma$	3.4 Å
Depth of Potential Well, ε	1.67x10 <sup>-21</sup> J
Mass of Argon, <i>m</i>	6.634x10 <sup>-26</sup> kg
Time Interval for Calculation	1 fs ( $\Delta t^{*}=1/2143$ )
Cut-off Length	3.5 σ



Fig.1 Arrangement of Solid (12×12×30)









Fig. 4 Temperature Profile

Fig. 5 Dependence on Pressure Fig.6 Dependence on Cross-section



示す結果が表現できる.

温度制御領域で高温部を維持するために与えた単位時 間当たりのエネルギーか、低温部を維持するために奪った 単位時間当たりエネルギーから熱流速が計算できるが、定 常状態では両者は一致する(Fig. 3). Fig. 3 と Fig. 4 は大き さが 18×18×30 の系で平均温度を 40K, 温度差∆T = 4K にし て計算した例で Fig.4 は系の温度分布を, Fig.3 は計算時間 の間に与えたエネルギーと奪ったエネルギーの積算値を 示す.これらの積算値の傾きが熱流速に相当する.なお, このように直接に温度勾配を加える方法では両端の温度 差 (熱流速)の影響が問題になるが 18×18×30 の系で平均温 度 8K,10K の場合に温度差を 1K~4K 程度まで変化させたが 計算された熱伝導率はほぼ一定であった.

## 3. 結果と考察

自由電子による熱伝導への寄与が大きい金属と異なり アルゴンのように電気絶縁体の熱伝導は格子振動に起因 し、固体が圧縮と引張状態での熱伝導率はゼロ応力の場合 と異なると予測される.この影響を調べるために分子間距 離を変化させて圧縮、ゼロ応力、引張状態で熱伝導率を測 定した. Fig. 5は系の平均温度が10K, 40Kの場合に系の内 部圧力変化に対する熱伝導率の挙動を示すものである.応 力を引張りの方に加えるほど熱伝導率が低下する傾向が わかり、従来の実験やシミュレーション結果と一致する(6).

熱伝導率に対する系のサイズ効果を評価するために大 きさ18×18×30を基準にして断面積及び長さを変化させた. Fig.6は伝熱方向と垂直な断面積の影響を,そして Fig.7 は 長さの影響を示したものである. Fig. 6 に示したように, 伝熱方向に垂直な断面積サイズに関する依存性は比較的 小さい.この理由の一つは横方向に周期境界条件を用いた ためとも考えられるが、さらに詳細な検討が必要である. 一方、伝熱方向のサイズ依存性は顕著であり、サイズが小 さくなると熱伝導率は極端に小さくなる.特に,熱伝導率 が大きくなる10Kの場合には本報の大きさ程度ではバルク の値より相当に小さくなる.

-般に格子振動による固体の熱伝導率λは, フォノンを 用いて $\lambda \propto C_v v l$ と表現される.ここで、 $C_v, v, l$ は、それぞ れ,比熱,フォノンの群速度,フォノンの平均自由行程を 示す. 熱伝導率は低温においては Cvが温度の低下とともに 減少するために減少し、高温域ではフォノンの平均自由行 程1が温度上昇とともに減少して減少すると説明されてい る. 系のサイズが平均自由行程程度かそれより小さくなる と、熱伝導率は減少すると考えられ、Fig. 7 のサイズ効果 に示すように温度が低くバルクな場合の平均自由行程が 大きくなるほど、サイズ効果は顕著に表れる.

ところが Fig. 8 に示すように古典分子動力学においては 量子効果による比熱の減少を表現できない. アルゴン固体 のようにデバイ温度が小さい場合は極低温の特殊な場合 としても良いがカーボンナノチューブやダイヤモンドの ようにデバイ温度が高い場合には常温においても問題と なる. 当然であるが Fig. 9 に示すように古典分子動力学法 によって計算される熱伝導率の温度変化はピークをもた ず温度が下がるほど熱伝導率が高くなる.ただし低温とな ってフォノンの平均自由行程が大きくなるほど系のサイ ズ効果が顕著となり、極低温の熱伝導率はおおよそ一定値 に近づいてしまう.

参考文献 (1) M. I. Flik, 他 2 名, J. Heat Transfer, 114 (1992), 666. (2) G. Chen, Phys. Rev. B, 57-23 (1998), 14958. (3) 松 本・他 3 名, 37 回伝熱シンポ(2000), 975. (4) J. Q. Broughton & G. H. Gilmer, J. Chem. Phys., 79-10 (1983), 5095. (5) E. R. Dobbs & G. O. Jones, Rep. Prog. Phys., 20 (1957), 516. (6) H. Kaburaki, 他 2 名, Mat. Res. Soc. Symp., 538 (1999), 503. (7)D. K. Christen & G. L. Pollack, Phys. Rev. B, 12-8 (1975), 3380.